

PCT

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
Bureau international

DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets 7 :

H01L 27/12, 21/84

A1

(11) Numéro de publication internationale: WO 00/46858

(43) Date de publication internationale: 10 août 2000 (10.08.00)

(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR00/00268

(22) Date de dépôt international: 4 février 2000 (04.02.00)

(30) Données relatives à la priorité: 99/01369  
5 février 1999 (05.02.99)

FR

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE [FR/FR]; 31-33, rue de la Fédération, F-75752 Paris 15<sup>ème</sup> (FR).

(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (US seulement): PELLOIE, Jean-Luc [FR/FR]; 83, rue Roger Dumarais, Villa N°7, F-38430 Moirans (FR).

(74) Mandataire: WEBER, Etienne; Brevatome, 3, rue Du Docteur Lancereaux, F-75008 Paris (FR).

(81) Etats désignés: JP, US, brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Publiée

Avec rapport de recherche internationale.

(54) Title: MOS TRANSISTOR WITH DYNAMIC THRESHOLD VOLTAGE EQUIPPED WITH A CURRENT LIMITING DEVICE AND METHOD FOR MAKING SAME

(54) Titre: TRANSISTOR MOS A TENSION DE SEUIL DYNAMIQUE EQUIPE D'UN LIMITEUR DE COURANT, ET PROCEDE DE REALISATION D'UN TEL TRANSISTOR

(57) Abstract

The invention concerns a semiconductor device comprising on a substrate: a first MOS transistor (10) with dynamic threshold voltage, with a gate (116), and a channel having one first type of conductivity, and a current limiting element (20) connected between said first transistor gate and channel. The invention is characterised in that said first transistor is provided with a first zone (160) doped with the first type of conductivity, connected to the channel, and the current limiting element comprises a second zone (124) doped with a second type of conductivity and electrically connected to the first zone by an ohmic connection. The invention is useful for producing CMOS circuits.

